

INA299 -2V 至 80V、双向、650kHz、高精度电流检测放大器

1 特性

- 宽共模电压：
 - 工作电压：-2V 至 +80V
 - 可承受电压：-12V 至 +85V
- 双向运行
- 较高的小信号带宽：650kHz (20V/V 增益)
- 压摆率：2.5V/ μ s
- 阶跃响应稳定时间为 1%：6.5 μ s
- 高 CMRR：120dB
- 增益误差 (最大值)： $\pm 0.25\%$ ， $\pm 10\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 漂移
- 失调电压 (最大值) $\pm 150\mu\text{V}$ ， $\pm 0.5\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 温漂
- 由 2.7V 至 12V 电源供电
- 工作电流：650 μ A
- 可用增益：
 - INA299A1：20V/V
 - INA299A2：50V/V
 - INA299A3：100V/V
- 封装选项：SOT23-6 (DBV)

2 应用

- 直流/直流转换器
- ESS 电池管理系统 (BMS)
- 宏远程无线电单元 (RRU)
- 48V 机架式服务器
- 48V 商用网络和服务电源 (PSU)

3 说明

INA299 是一款精密双向电流检测放大器，可在 -2V 至 80V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降，与电源电压无关。该器件在低失调电压 ($\pm 150\mu\text{V}$ ，最大值)、较小增益误差 ($\pm 0.25\%$ ，最大值) 和高直流 CMRR (典型值为 120dB) 等特性的综合作用下，可实现高精度电流测量。INA299 拥有 650kHz 的高信号带宽和快速稳定时间，不仅适用于高压双向直流电流测量，还适用于高速应用 (例如，瞬态检测和快速过流保护)。

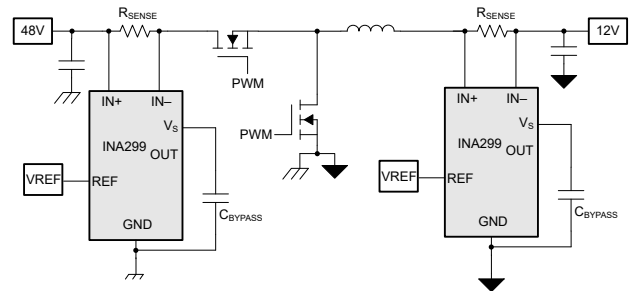
INA299 由 2.7V 至 12V 的单电源供电，消耗 650 μ A 的电源电流。INA299 有三个增益选项：20V/V、50V/V 和 100V/V。运用多个增益选项，可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态范围要求之间进行优化。

INA299 的额定工作温度范围为 -40°C 至 $+125^\circ\text{C}$ ，并且采用 6 引脚 SOT-23 封装。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
INA299	DBV (SOT-23, 6)	2.90mm × 2.80mm

- (1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的封装选项附录。
 (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



典型应用 - 直流/直流转换器



内容

1 特性	1	7.1 应用信息	16
2 应用	1	7.2 典型应用	17
3 说明	1	7.3 电源相关建议	18
4 引脚配置和功能	2	7.4 布局	18
5 规格	3	8 器件和文档支持	20
5.1 绝对最大额定值.....	3	8.1 文档支持.....	20
5.2 ESD 等级.....	3	8.2 接收文档更新通知.....	20
5.3 建议运行条件.....	3	8.3 支持资源.....	20
5.4 热性能信息.....	3	8.4 商标.....	20
5.5 电气特性.....	4	8.5 静电放电警告.....	20
5.6 典型特性.....	6	8.6 术语表.....	20
6 详细说明	12	9 修订历史记录	20
6.1 概述.....	12	10 机械、封装和可订购信息	20
6.2 功能方框图.....	12	10.1 机械数据.....	21
6.3 特性说明.....	12	封装选项附录.....	24
6.4 器件功能模式.....	12	10.2 卷带包装信息.....	25
7 应用和实施	16		

4 引脚配置和功能

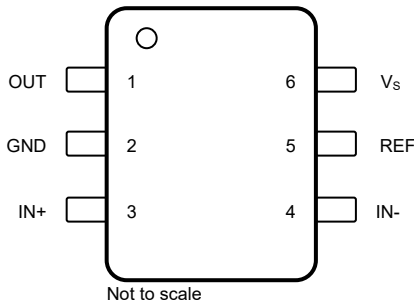


图 4-1. INA299 : DVB 封装 6 引脚 SOT-23 顶视图

表 4-1. 引脚功能 : DBV 封装

引脚		类型	说明
名称	编号		
GND	2	接地	接地
IN+	3	输入	电流检测放大器正输入。对于高侧应用，连接至检测电阻的总线电压侧。对于低侧应用，连接至检测电阻的负载侧。
IN -	4	输入	电流检测放大器负输入。对于高侧应用，连接至检测电阻的负载侧。对于低侧应用，连接至检测电阻的接地侧。
OUT	1	输出	输出电压
REF	5	输入	基准电压。从 0V 至 V_S ，连接到电压电势；有关连接选项，请参阅 使用基准引脚调整输出 。
V_S	6	电源	电源，2.7 V 至 12 V

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电源电压 (V_S)	$(V_S - GND)$	-0.3	13.2	V
模拟输入, V_{IN+} 、 V_{IN-} ⁽²⁾	差分 (V_{IN+})-(V _{IN-})	-6	6	V
模拟输入, V_{IN+} 、 V_{IN-} ⁽²⁾	共模	-12	85	V
REF		GND - 0.3	$V_S + 0.3$	V
输出		GND - 0.3	$V_S + 0.3$	V
T_A	工作温度	-55	150	°C
T_J	结温		150	°C
T_{stg}	贮存温度	-65	150	°C

- (1) 在 **绝对最大额定值** 范围外运行可能会对器件造成永久损坏。**绝对最大额定值** 并不表示器件能够在该等条件下或在任何超出 **建议运行条件** 的其他条件下正常运行。如果在 **建议运行条件** 以外,但在 **绝对最大额定值** 范围以内使用器件可能无法完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能与性能,并且可能缩短器件寿命。
- (2) V_{IN+} 和 V_{IN-} 分别为 $IN+$ 和 $IN-$ 引脚上的电压。

5.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准, 所有引脚 ⁽¹⁾	±2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准, 所有引脚 ⁽²⁾	±1000	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	标称值	最大值	单位
V_{CM}	共模输入范围	-2	48	80	V
V_S	工作电源电压范围	2.7	5	12	V
V_{SENSE}	差分检测输入范围	0		V_S / G	V
T_A	环境温度	-40		125	°C

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		INA299	单位
		DBV (SOT-23)	
		6 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	158.8	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	76.9	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	41.4	°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	17.3	°C/W
Ψ_{JB}	结至电路板特征参数	41.1	°C/W

热指标 ⁽¹⁾		INA299	单位
		DBV (SOT-23)	
		6 引脚	
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用手册。

5.5 电气特性

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $V_{REF} = V_S / 2$ 、 $V_{SENSE} = 0\text{V}$ 、 $V_{CM} = V_{IN-} = 48\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入						
V_{CM}	共模输入范围 ⁽¹⁾	$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$	-2		80	V
CMRR	共模抑制比， 以输入为基准	$2.5\text{V} < V_{CM} < 80\text{V}$ ，	110	120		dB
		$0\text{V} < V_{CM} < 80\text{V}$ ，	80	90		
		$-2\text{V} < V_{CM} \leq 2.5\text{V}$ ，	65			
		$f = 50\text{kHz}$ 、 $V_{CM} = 12\text{V}$		65		
V_{os}	失调电压，以输入为基准	$V_{CM} = 2.5\text{V}$	-150		150	μV
		$V_{CM} = 2.5\text{V}$ 、 $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$	-200		200	
dV_{os}/dT	失调电压温漂	$V_{CM} = 2.5\text{V}$			± 0.5	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
PSRR	电源抑制比，以输入为基准	$V_{CM} = 2.5\text{V}$ 、 $2.7\text{V} \leq V_S \leq 12\text{V}$ 、 $V_{REF} = 1\text{V}$ $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$			± 6	$\mu\text{V}/\text{V}$
I_B	输入偏置电流	I_{B+} 、 I_{B-} 、 $V_{CM} = 2.5\text{V}$ 、 $V_{SENSE} = 0\text{V}$		13	± 21	μA
		I_{B+} 、 I_{B-} 、 $V_{CM} = 2.5\text{V}$ 、 $V_{SENSE} = 0\text{V}$ 、 $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$			± 28	
	基准输入范围		0		V_S	V
RVRR	基准电压抑制比， 以输入为基准	$V_{REF} = 0.5\text{V}$ 至 4.5V 、 $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$		± 5	± 20	$\mu\text{V}/\text{V}$
输出						
G	增益	INA299A1		20		V/V
		INA299A2		50		
		INA299A3		100		
G_{ERR}	增益误差	$V_{CM} = 2.5\text{V}$ 、 ($\text{GND} + 50\text{mV}$) $< V_{OUT} < (V_S - 200\text{mV})$			± 0.25	%
	增益误差漂移	$V_{CM} = 2.5\text{V}$ 、 $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$ 、 ($\text{GND} + 50\text{mV}$) $< V_{OUT} < (V_S - 200\text{mV})$			10	$\text{ppm}/^\circ\text{C}$
NL_{ERR}	非线性误差	$V_{OUT} = 0.5\text{V}$ 至 4.5V 、 $V_{CM} = 12\text{V}$		0.01		%
	最大容性负载	无持续振荡，无隔离电阻器		500		pF
电压输出						
	相对于 V_S (电源轨) 的摆幅	$V_{CM} = 2.5\text{V}$ 、 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 至 GND	4.9			V
	对地摆幅	$V_{CM} = 2.5\text{V}$ 、 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 至 GND			80	mV
频率响应						
BW	带宽	INA299A1		650		kHz
		INA299A2		500		
		INA299A3		400		

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $V_{\text{REF}} = V_S / 2$ 、 $V_{\text{SENSE}} = 0\text{V}$ 、 $V_{\text{CM}} = V_{\text{IN-}} = 48\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	稳定时间	V _{OUT} = 0.5V 至 4.5V 阶跃、 输出稳定至 1%	6.5			μs
		V _{OUT} = 0.5V 至 4.5V 阶跃、 输出稳定至 5%	3			
SR	压摆率	INA299A1，V _{SENSE} = ±100mV， INA299A2，V _{SENSE} = ±40mV， INA299A3，V _{SENSE} = ±20mV，	2.5			V/μs
噪声						
Ven	电压噪声密度	f > 10kHz	117			nV/√Hz
电源						
I _Q	静态电流	V _{CM} = 2.5V	450	600		μA
		V _{CM} = 2.5V、T _A = -40°C 至 +125°C	650			μA
		V _{CM} = -2V	950	1100		μA
		V _{CM} = -2V、T _A = -40°C 至 +125°C	1200			μA
T _A	指定的范围		-40		125	°C

(1) $V_{\text{IN+}}$ 和 $V_{\text{IN-}}$ 的共模电压不得超过指定的共模输入范围。

5.6 典型特性

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $V_{\text{SENSE}} = V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} = 0\text{V}$ 、 $V_{\text{CM}} = V_{\text{IN}-} = 48\text{V}$ 且 $V_{\text{REF}} = V_S / 2$ 时测得 (除非另有说明)

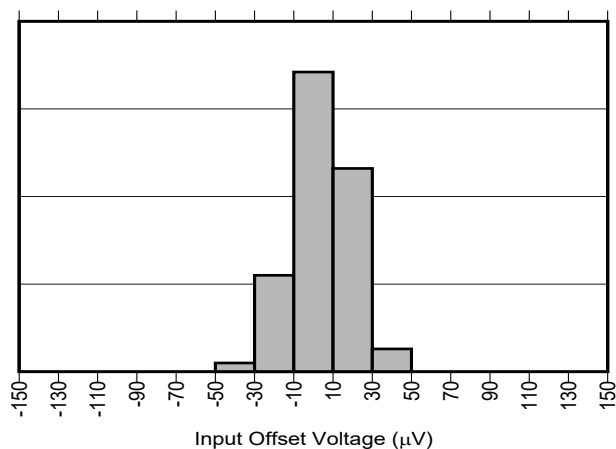


图 5-1. INA299 输入失调电压产生分布图

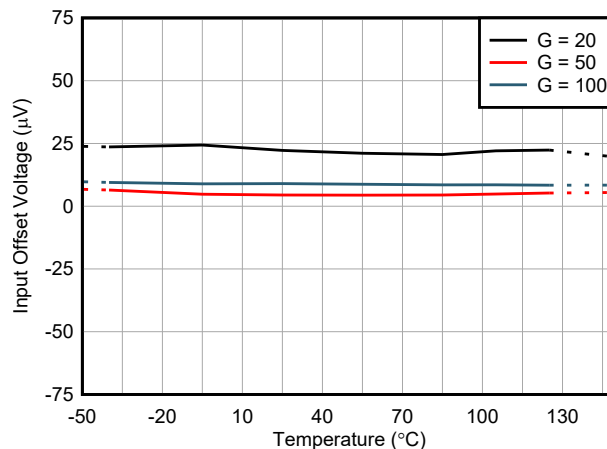


图 5-2. 输入失调电压与温度间的关系

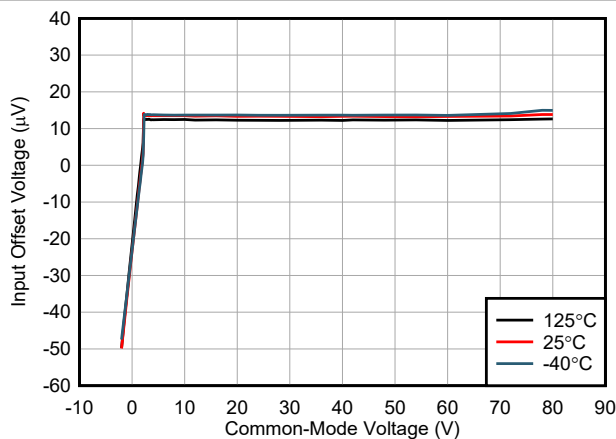


图 5-3. 输入失调电压与共模电压间的关系

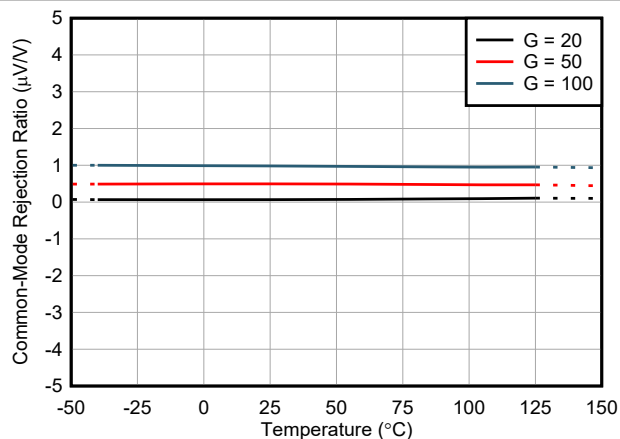


图 5-4. 共模抑制比与温度间的关系

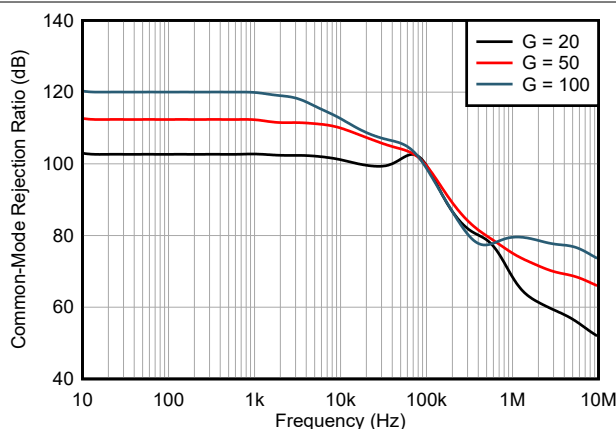


图 5-5. 共模抑制比与频率间的关系

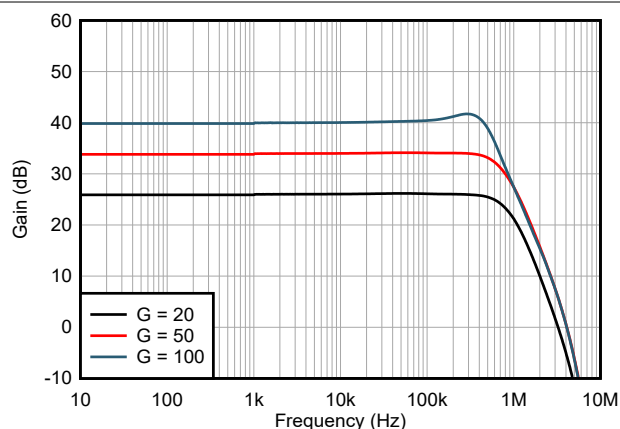


图 5-6. 增益与频率间的关系

5.6 典型特性 (续)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $V_{\text{SENSE}} = V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} = 0\text{V}$ 、 $V_{\text{CM}} = V_{\text{IN}-} = 48\text{V}$ 且 $V_{\text{REF}} = V_S / 2$ 时测得 (除非另有说明)

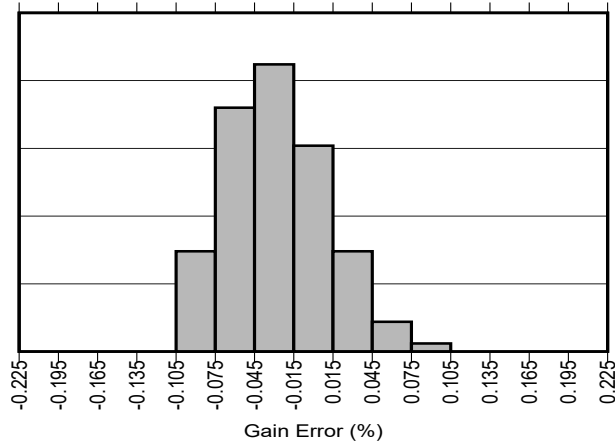


图 5-7. INA299 增益误差产生分布图

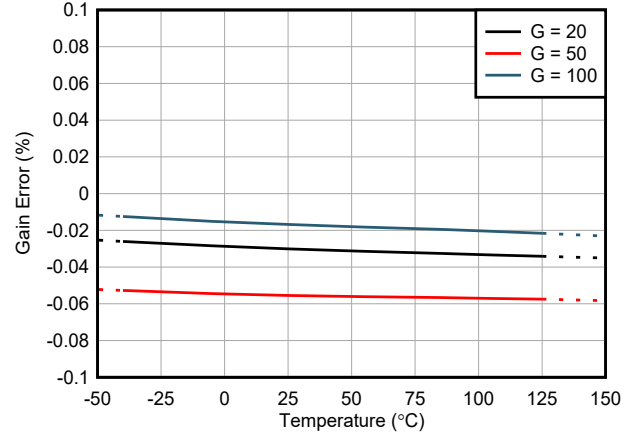


图 5-8. 增益误差与温度间的关系

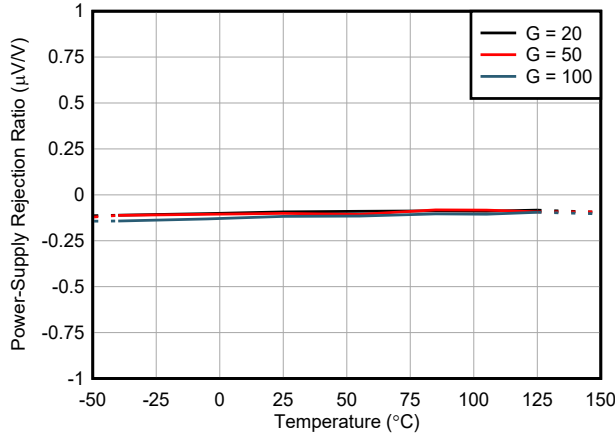


图 5-9. 电源抑制比与温度间的关系

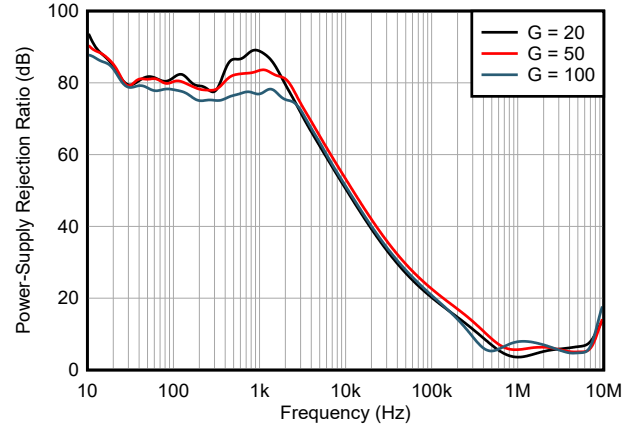


图 5-10. 电源抑制比与频率间的关系

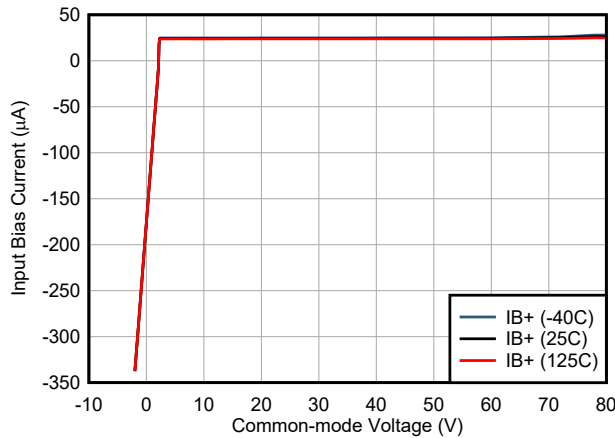


图 5-11. 输入偏置电流与共模电压间的关系

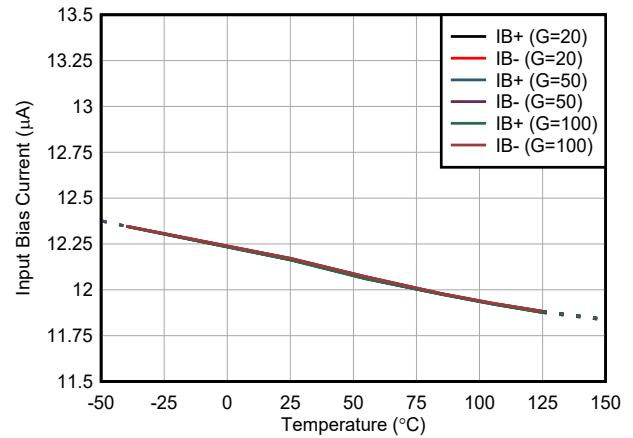


图 5-12. 输入偏置电流与温度间的关系

5.6 典型特性 (续)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $V_{\text{SENSE}} = V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} = 0\text{V}$ 、 $V_{\text{CM}} = V_{\text{IN}-} = 48\text{V}$ 且 $V_{\text{REF}} = V_S / 2$ 时测得 (除非另有说明)

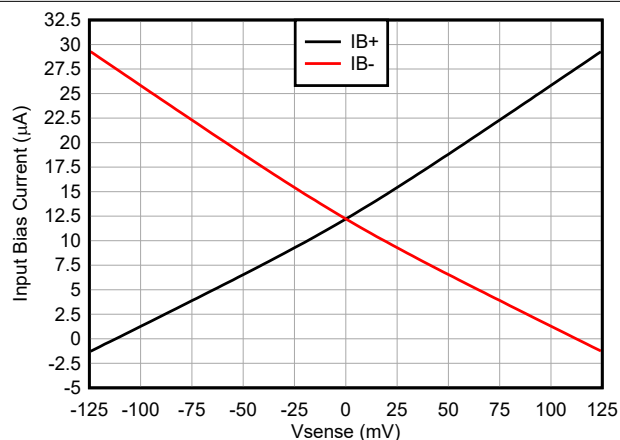


图 5-13. INA299 增益 = 20V/V，输入偏置电流与 V_{SENSE} 间的关系

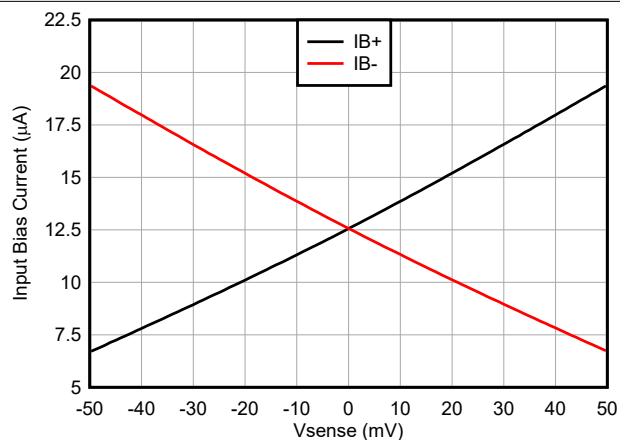


图 5-14. INA299 增益 = 50V/V，输入偏置电流与 V_{SENSE} 间的关系

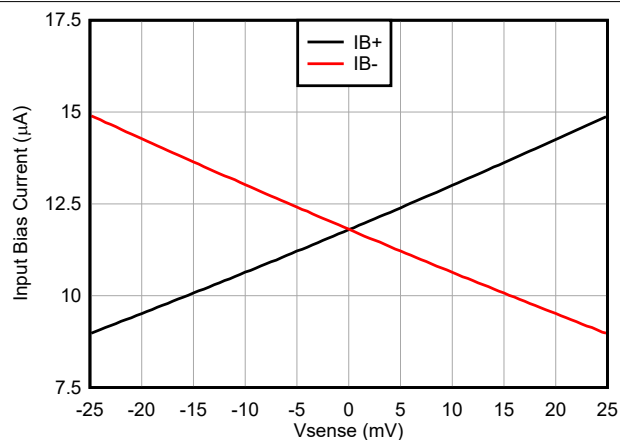


图 5-15. INA299 增益 = 100V/V，输入偏置电流与 V_{SENSE} 间的关系

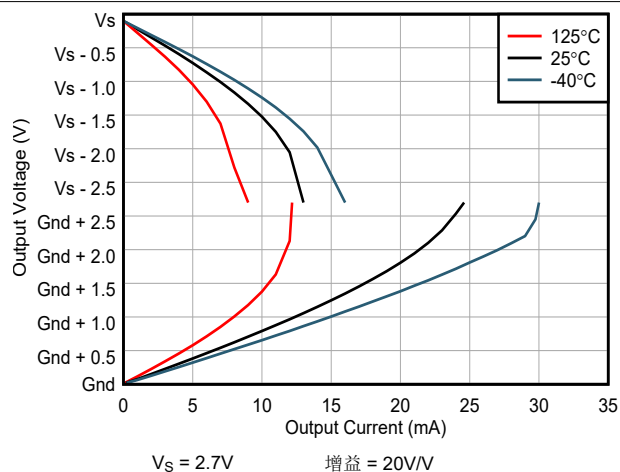


图 5-16. 输出电压与输出电流间的关系

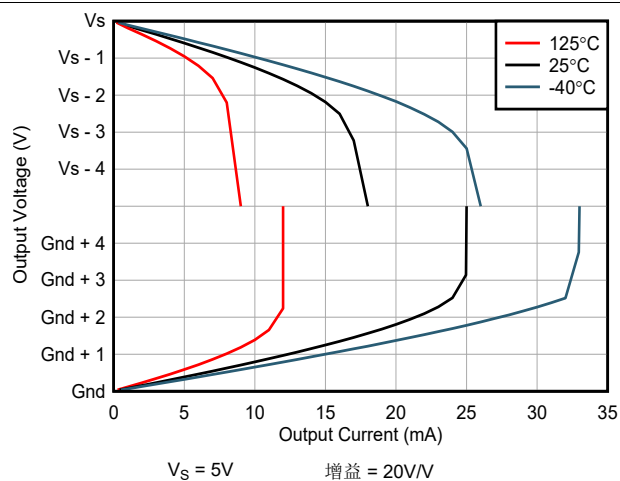


图 5-17. 输出电压与输出电流间的关系

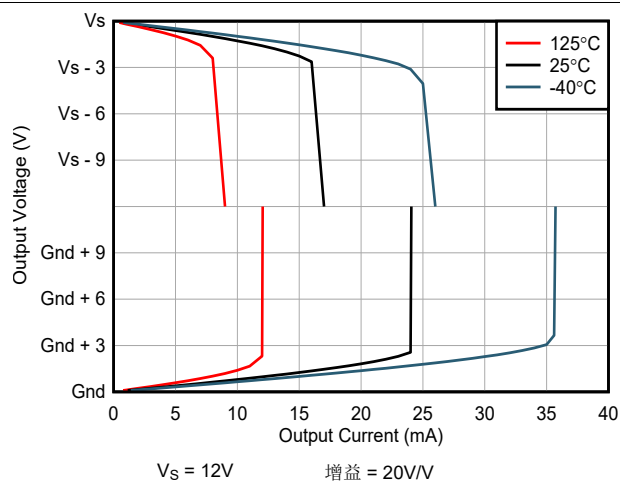


图 5-18. 输出电压与输出电流间的关系

5.6 典型特性 (续)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $V_{\text{SENSE}} = V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} = 0\text{V}$ 、 $V_{\text{CM}} = V_{\text{IN}-} = 48\text{V}$ 且 $V_{\text{REF}} = V_S / 2$ 时测得 (除非另有说明)

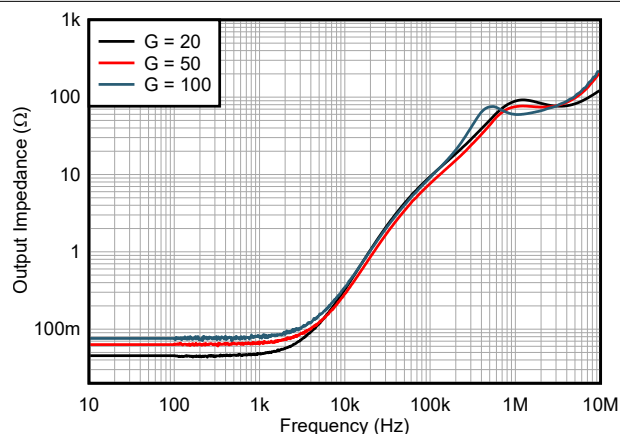
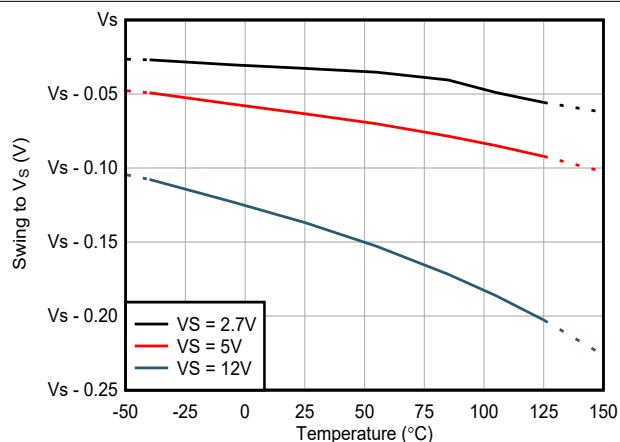
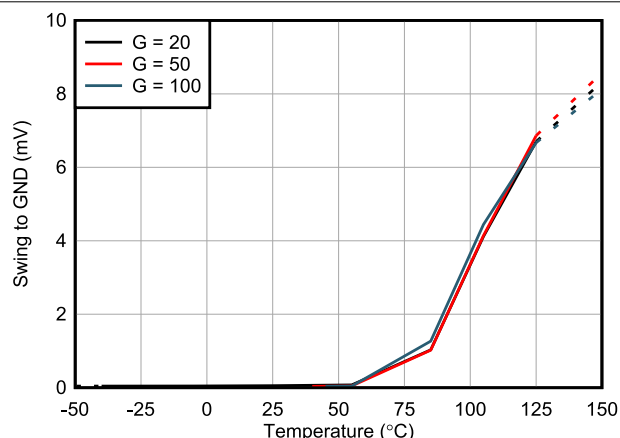


图 5-19. 输出阻抗与频率间的关系



$R_L = 10\text{k}\Omega$ 至 GND

图 5-20. 电源摆幅与温度间的关系



$R_L = 10\text{k}\Omega$ 至 GND

图 5-21. 相对于 GND 的摆幅与温度间的关系

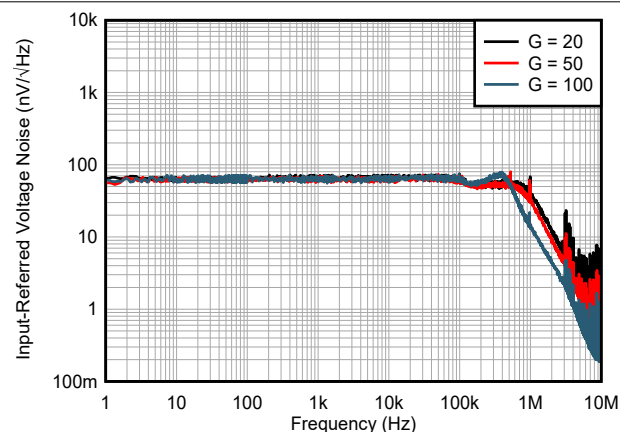


图 5-22. 输入参考噪声与频率间的关系

5.6 典型特性 (续)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $V_{\text{SENSE}} = V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} = 0\text{V}$ 、 $V_{\text{CM}} = V_{\text{IN}-} = 48\text{V}$ 且 $V_{\text{REF}} = V_S / 2$ 时测得 (除非另有说明)

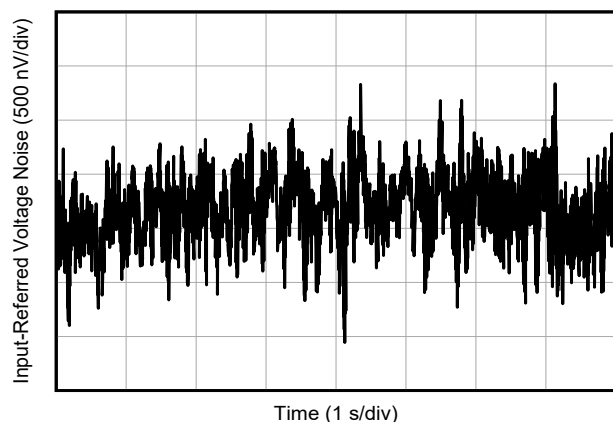


图 5-23. 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声

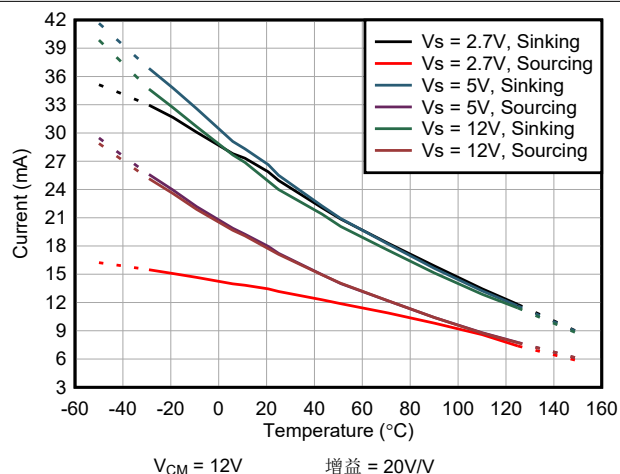


图 5-24. 短路电流与温度间的关系

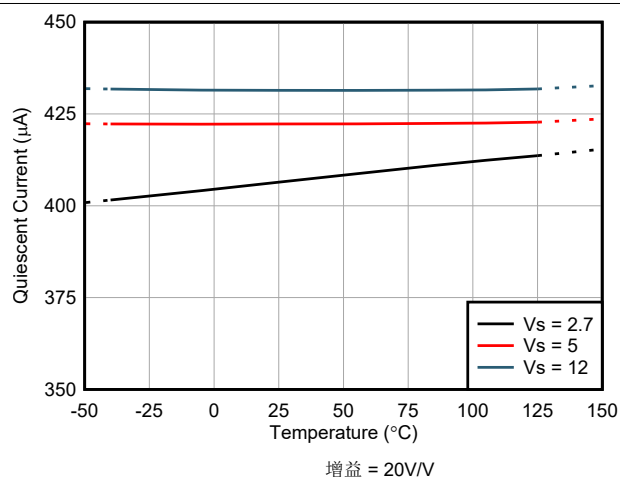


图 5-25. 静态电流与温度间的关系

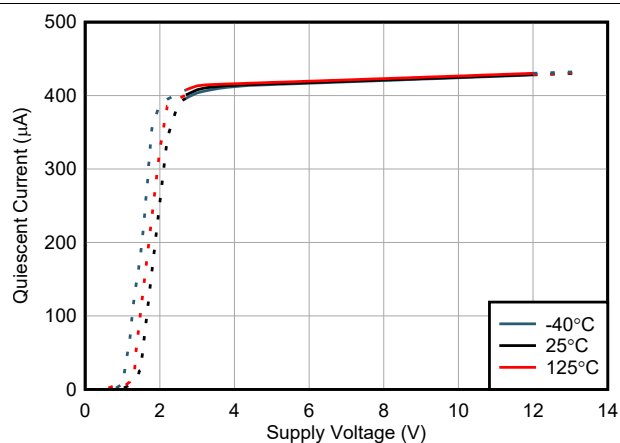


图 5-26. 静态电流与电源电压间的关系

5.6 典型特性 (续)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $V_{\text{SENSE}} = V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} = 0\text{V}$ 、 $V_{\text{CM}} = V_{\text{IN}-} = 48\text{V}$ 且 $V_{\text{REF}} = V_S / 2$ 时测得 (除非另有说明)

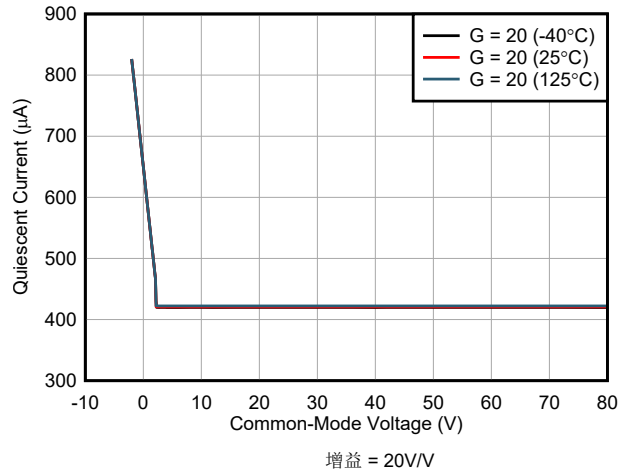


图 5-27. 静态电流与共模电压间的关系

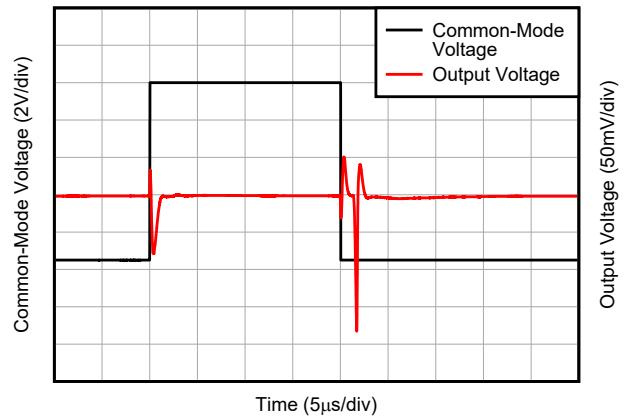


图 5-28. 共模电压快速瞬态脉冲

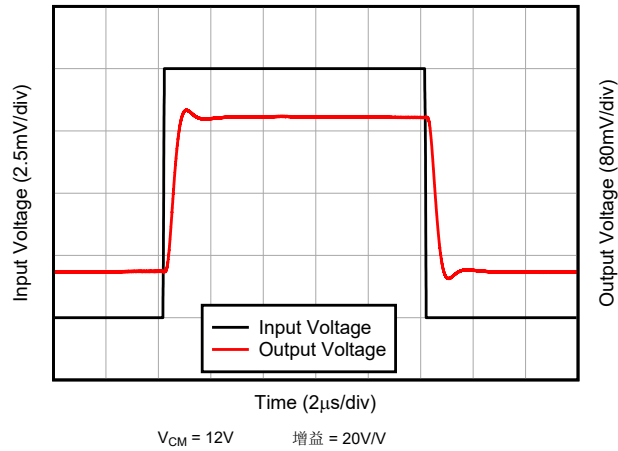


图 5-29. 小阶跃响应

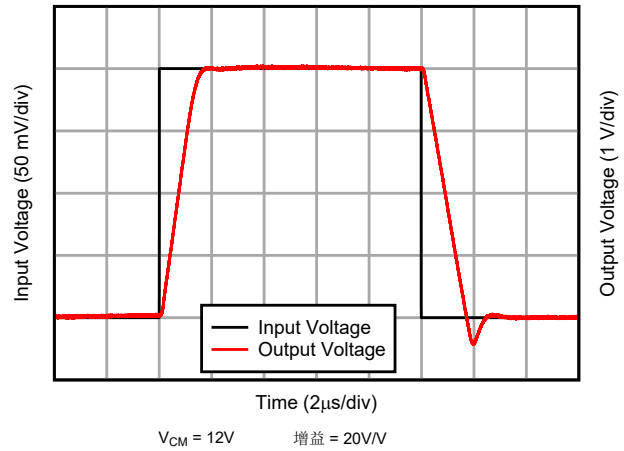


图 5-30. 大阶跃响应

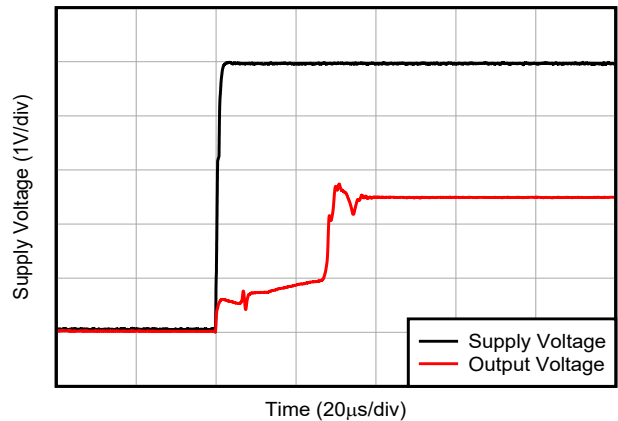


图 5-31. 启动响应

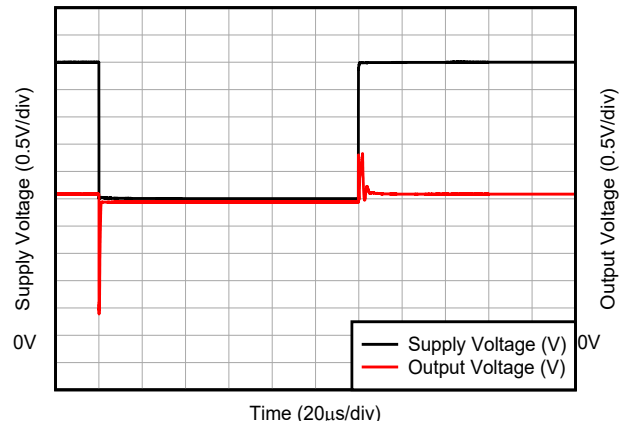


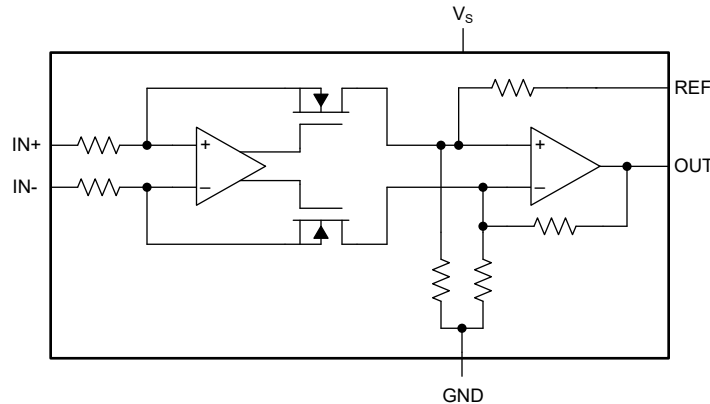
图 5-32. 欠压恢复

6 详细说明

6.1 概述

INA299 是一款高侧或低侧双向高带宽电流检测放大器，具有宽共模范围、高精度、零漂移拓扑、良好的共模抑制比 (CMRR) 和快速压摆率。它有不同的增益版本，以便根据应用来优化输出动态范围。INA299 使用特定的架构进行设计，可实现 $13\mu\text{A}$ 的低偏置电流，额定共模电压范围为 -2V 至 80V ，信号带宽高达 650kHz 。

6.2 功能方框图



6.3 特性说明

6.3.1 放大器输入共模信号

INA299 支持从 -2V 至 $+80\text{V}$ 的宽输入共模电压。INA299 的内部拓扑允许共模范围超过电源电压 (V_S)。因此，INA299 可用于超出 2.7V 至 12V 电源电压范围的低侧或高侧电流检测应用。

6.3.2 低输入偏置电流

在共模电压高达 80V 时，INA299 输入的每个输入引脚消耗 $13\mu\text{A}$ (典型值) 偏置电流，可在需要较低电流泄漏的应用中实现精密的电流检测。输入偏置电流与 -2V 至 2.5V 的共模电压成正比，之后 INA299 的输入偏置电流在整个共模电压范围内保持恒定。

6.3.3 低 V_{SENSE} 运行

INA299 在整个有效的 V_{SENSE} 范围内实现高性能运行。INA299 的零漂移输入架构提供在 -40°C 至 $+125^\circ\text{C}$ 的宽工作温度范围内准确测量低 V_{SENSE} 电平所需的低失调电压和低温漂。当使用低欧姆值分流器进行低电流测量时，因为分流器上的功率损耗显著降低，所以低 V_{SENSE} 运行特别有益。

6.3.4 宽固定增益输出

在室温下，INA299 最大增益误差为 $\pm 0.25\%$ ；在 -40°C 至 $+125^\circ\text{C}$ 的整个温度范围内，最大温漂为 $\pm 10\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 。INA299 提供了多种增益选项： 20V/V 、 50V/V 和 100V/V ，系统设计人员应根据其所需的信噪比和其他系统要求 (例如，动态电流范围和满量程输出电压目标) 进行选择。

6.3.5 宽电源电压

INA299 可在 2.7V 至 12V 的电源电压范围内工作。虽然 INA299 的输入共模电压范围与电源电压无关，但输出电压受施加到器件的电源电压的约束。输出电压可以从低至 80mV 到高至 100mV 不等，但要低于电源电压。

6.4 器件功能模式

6.4.1 使用基准引脚调整输出

图 6-1 显示了当差分输入电压为 0V 时，在分压电源电压下驱动以将输出偏置在相同电压的基准引脚。INA299 输出可配置为支持单向或双向运行。

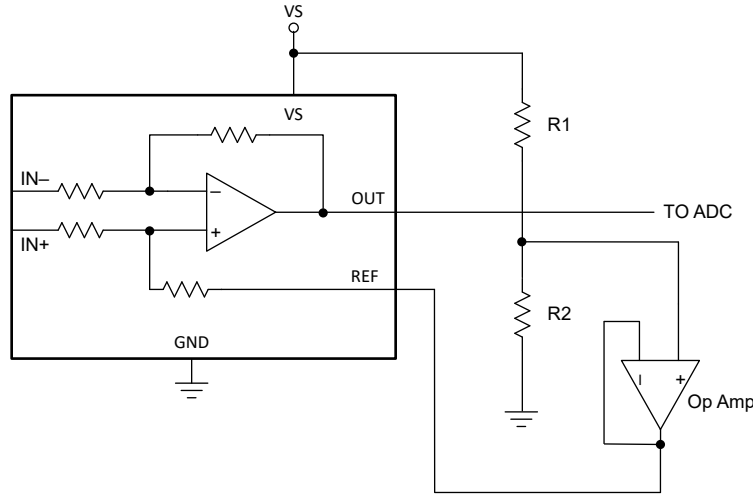


图 6-1. 基准引脚调节输出

通过向基准输入引脚 REF 施加电压来设置输出电压。REF 连接到精确匹配的內部增益网络。当 REF 连接到缓冲分压电源电压时，且电流检测输入电压为 0V 时，输出设置为中点电压，如 [方程式 1](#) 所示。在大多数双向应用中，REF 被驱动至中点电压，以将输出电压设置为中点电压。

$$V_{OUT} = G \times (V_{IN+} - V_{IN-}) + V_{REF} \quad (1)$$

6.4.2 单向电流测量的基准引脚连接

单向操作允许通过电阻分流器在一个方向上测量电流。对于单向操作，将器件基准引脚连接到负轨（参阅 [以接地为基准的输出](#) 部分）或正轨（参阅 [以 VS 为基准的输出](#) 部分）。所需的差分输入极性取决于基准输入设置。放大器输出与基准轨的偏离与通过外部分流电阻器的电流成比例。如果放大器基准引脚连接到正轨，则输入极性必须为负才能将放大器输出向下移动（朝向地）。如果将放大器基准引脚接地，则输入极性必须为正才能使放大器输出向上移动（朝向电源）。

以下各部分描述了如何为单向操作情况配置输出。

6.4.2.1 以接地为基准的输出

在单向模式下使用 INA299，且具有以接地为基准的输出时，基准输入连接到地。当输入具有 0V 差分电压时（请参阅 [图 6-2](#)），此配置将输出接地。

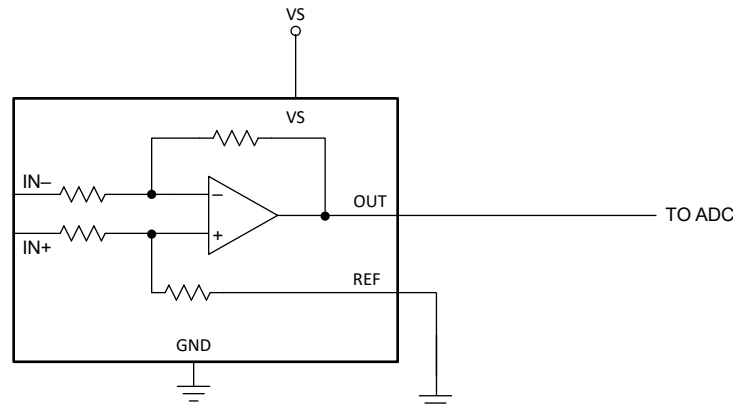


图 6-2. 以接地为基准的输出

6.4.2.2 以 VS 为基准的输出

通过将基准引脚连接到正电源来配置输出以 VS 为基准的单向模式。针对具有负电流幅度的电路使用该配置。当输入具有 0V 差分电压时（请参阅图 6-3），此配置将输出接至电源。

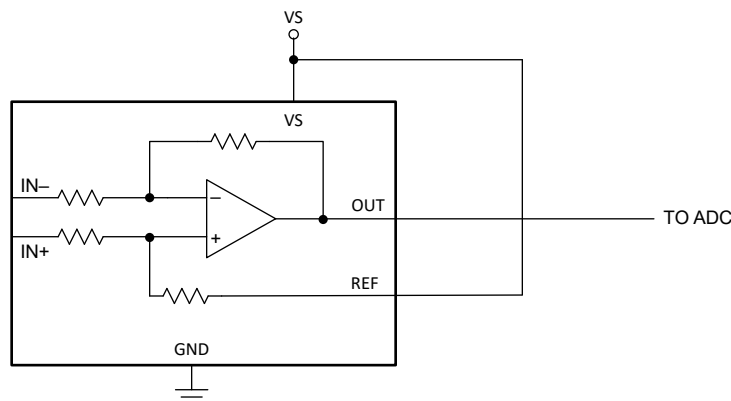


图 6-3. 以 VS 为基准的输出

6.4.3 双向电流测量的基准引脚连接

INA299 测量流经电阻器（通常称为电流检测电阻器或分流电阻器）的电流产生的差分电压。根据基准引脚上的电压电势，INA299 可以在单向或双向模式下运行。

输出级的线性范围受限于输出电压接近地的程度以及电源电压，如规格中所述。电流检测电阻的值、要测量的电流范围、最佳增益选项以及施加到基准引脚的电压，都应该使 INA299 保持在线性工作区域内。

6.4.3.1 将输出设置为外部基准电压

将基准引脚连接到外部基准电压会导致以下结果：在输入引脚短路或 0V 差分输入的情况下，输出电压等于基准电压。图 6-4 显示此配置。当 IN+ 引脚相对于 IN- 引脚为负时，输出电压降至基准电压以下；当 IN+ 引脚相对于 IN- 引脚为正时，输出电压增加。这种技术是将输出偏置到精确电压的准确方法。

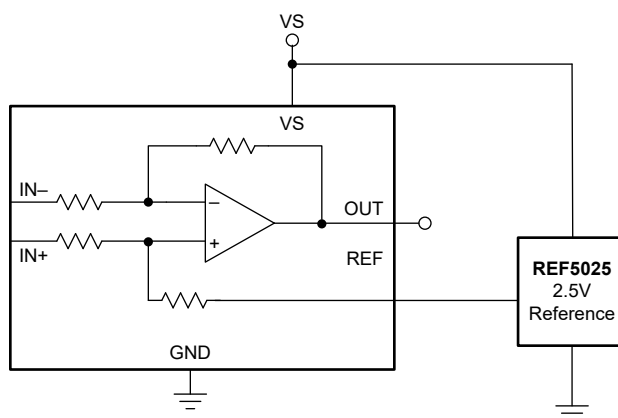


图 6-4. 外部基准输出

6.4.3.2 输出设置为 1/2 Vs 电压

图 6-5 显示了当没有差分输入时，通过将基准引脚连接至平均分压电源电压 VS，从而将输出设置为电源电压的一半。这种方法会使电源电压产生比例式偏移，在这种情况下，输出电压保持在 $VS/2$ （对于在输入端施加的 0V）。

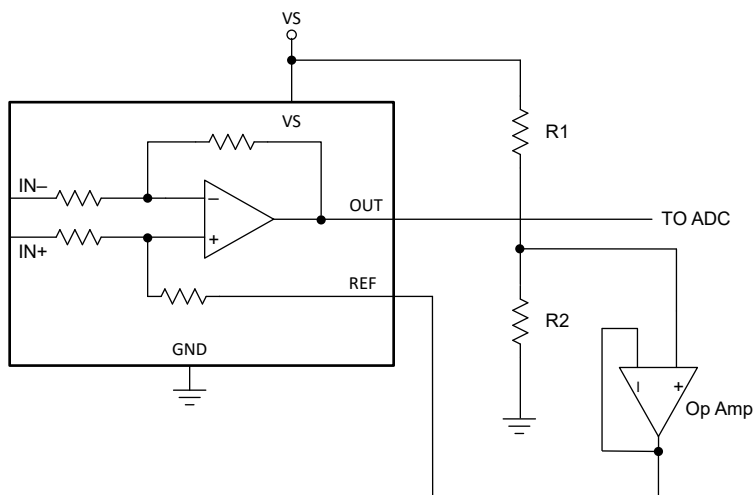


图 6-5. $1/2 V_s$ 电压输出

7 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

7.1 应用信息

当电流经电阻流向负载时，INA299 会将在电流检测电阻器两端产生的电压放大。INA299 具有宽输入共模电压范围和高共模抑制比，因此可使用各种电压轨，同时仍能维持精确的电流测量。

7.1.1 R_{SENSE} 和器件增益选择

通过选择尽可能最大的电流检测电阻值，可以提高任何电流检测放大器的精度。较大的检测电阻值可在给定电流流量下使差分输入信号达到最大，并减小失调电压的误差贡献。但是，由于封装的物理尺寸、封装结构和最大功耗不同，在给定的应用中，对于电流检测电阻值可以有多大存在一些实际限制。方程式 2 给出了在给定功率损耗预算下，电流检测电阻的最大值。

$$R_{SENSE} < \frac{PD_{MAX}}{I_{MAX}^2} \quad (2)$$

其中：

- PD_{MAX} 是 R_{SENSE} 中的最大允许功率损耗。
- I_{MAX} 是流过 R_{SENSE} 的最大电流。

电流检测电阻的大小和器件增益的其他限制取决于电源电压 V_S 和器件摆幅至轨限制。为了验证电流检测信号是否正确传递到输出端，必须检查正负输出摆幅限制。方程式 3 提供了 R_{SENSE} 和 $GAIN$ 的最大值，以便防止设备超过正摆幅限制。

$$I_{MAX} \times R_{SENSE} \times GAIN < V_{SP} \quad (3)$$

其中：

- I_{MAX} 是流过 R_{SENSE} 的最大电流。
- $GAIN$ 是电流检测放大器的增益。
- V_{SP} 是器件的正输出摆幅，如规格中所指定。

为了避免在选择 R_{SENSE} 的值时出现正输出摆幅限制，在检测电阻的值与所考虑的器件增益之间总是存在权衡。如果为最大功率损耗选择的检测电阻太大，则可以选择较低的增益器件以避免正摆幅限制。

负摆幅限制对给定应用的检测电阻值可以小到何种程度施加了限制。方程式 4 提供了对感测电阻最小值的限制。

$$I_{MIN} \times R_{SENSE} \times GAIN > V_{SN} \quad (4)$$

其中：

- I_{MIN} 是流过 R_{SENSE} 的最小电流。
- $GAIN$ 是电流检测放大器的增益。
- V_{SN} 是器件的负输出摆幅，如规格中所指定。

表 7-1 显示了使用 INA299 的五个不同增益版本所获得的不同结果示例。从表格数据中可以看出，最高增益的器件支持使用较小的分流电阻器并降低元件中的功率损耗。

表 7-1. R_{SENSE} 选择和功率损耗 (1)

参数		等式	$V_S = 5V$ 时的结果		
			A1 器件	A2 器件	A3 器件
G	增益		20V/V	50V/V	100V/V
V_{SENSE}	理想的差分输入电压	$V_{SENSE} = V_{OUT} / G$	250mV	100mV	50mV
R_{SENSE}	电流检测电阻值	$R_{SENSE} = V_{SENSE} / I_{MAX}$	25m Ω	10m Ω	5m Ω
P_{SENSE}	电流检测电阻功率损耗	$R_{SENSE} \times I_{MAX}^2$	2.5W	1W	0.5W

(1) 设计示例，满量程电流为 10A，最大输出电压设置为 5V。

7.2 典型应用

INA299 是一款双向电流检测放大器，能够通过共模电压为 -2V 至 +80V 的电阻分流器来测量电流。

7.2.1 电机应用中的高侧电流检测

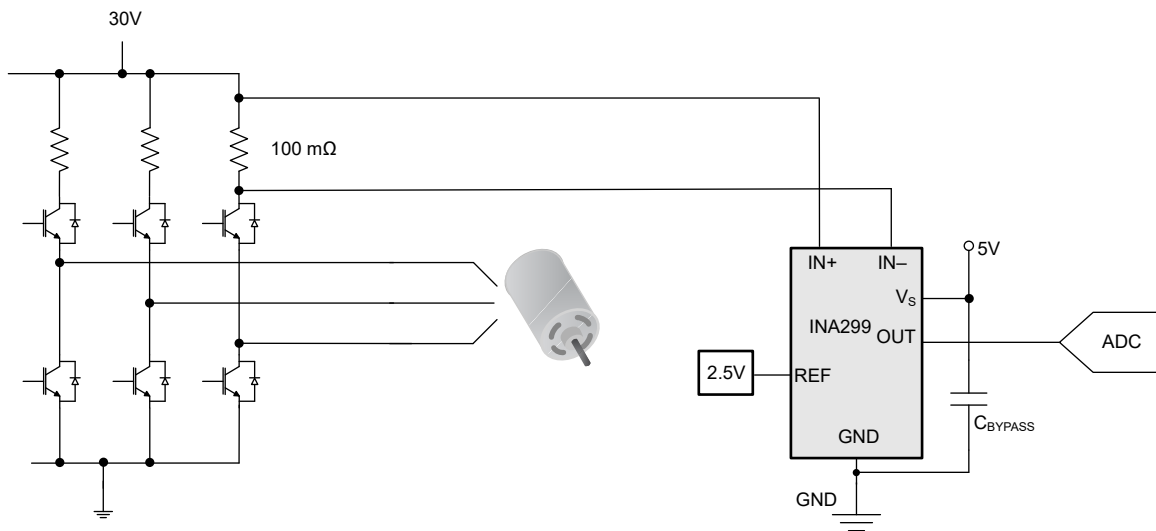


图 7-1. 高侧电机侧电流检测应用电路

7.2.1.1 设计要求

在此示例应用中，共模电压范围为 0V 至 30V。最大检测电流为 0.5A，并且为 INA299 提供 5V 电源。按照 [R_{SENSE}](#) 和 [器件增益选择](#) 中的设计指南，选定 100m Ω 的 R_{SENSE} 和 50V/V 的增益，以便提供良好的输出动态范围。表 7-2 列出了此应用的设计设置。

表 7-2. 设计参数

设计参数	示例值
电源电压	5V
共模电压范围	30V
最大感应电流	0.5A
R_{SENSE} 电阻器	100m Ω
增益选项	50V/V

7.2.1.2 详细设计过程

INA299 旨在测量电机应用中的典型高侧电流。INA299 测量电源上 100m Ω 分流器 (与用于驱动电机的半桥串联) 上的电流。INA299 测量分流电阻器的电压差，信号以 50V/V 的增益在内部放大。INA299 的输出连接到 MCU 的模数转换器 (ADC)，以使电流测量数字化。

通过测量电机上的电流，可以指示故障。测量高侧电流还可指示可能在应用中损坏的电机或 FET 上是否存在任何接地故障。具有高带宽和压摆率的 INA299 可用于检测快速过流情况，以便防止接地短路故障造成电机损坏。

7.2.1.3 应用曲线

图 7-2 显示了电机的电流响应。

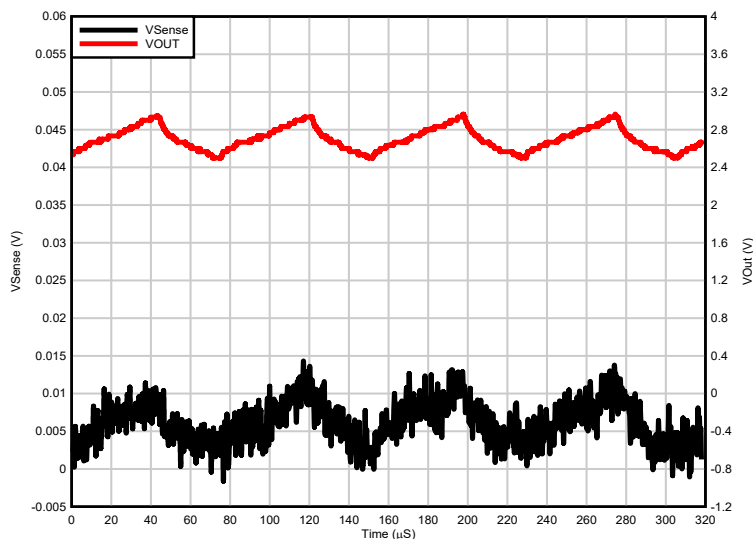


图 7-2. 高侧电机电流测量

7.3 电源相关建议

因为输入端 (IN+ 和 IN-) 可使用 -2V 和 +80V 之间的任何电压 (与 V_S 无关)，所以 INA299 可以在连接的电源电压 (V_S) 之外进行精确测量。例如，在 V_S 电源等于 5V 时，被测分流器的共模电压可高达 +80V。

7.3.1 电源去耦

电源旁路电容器的位置应尽可能靠近电源引脚和接地引脚。TI 建议使用 0.1 μF 的旁路电容值。可以添加额外的去耦电容以补偿噪声或高阻抗电源。

7.4 布局

7.4.1 布局指南

建议使用良好的布局实践。

- 使用开尔文连接或 4 线制连接将输入引脚连接到检测电阻器。这种连接技术可确保在输入引脚之间仅检测电流检测电阻的阻抗。电流检测电阻布线不良通常会导致在输入引脚之间存在额外的电阻。鉴于电流检测电阻的欧姆值非常低，任何额外的高载流阻抗都会导致严重的测量误差。
- 电源旁路电容器的位置应尽可能靠近器件电源引脚和接地引脚。此旁路电容器的建议值为 0.1 μF 。可以添加额外的去耦电容以补偿噪声或高阻抗电源。

7.4.2 布局示例

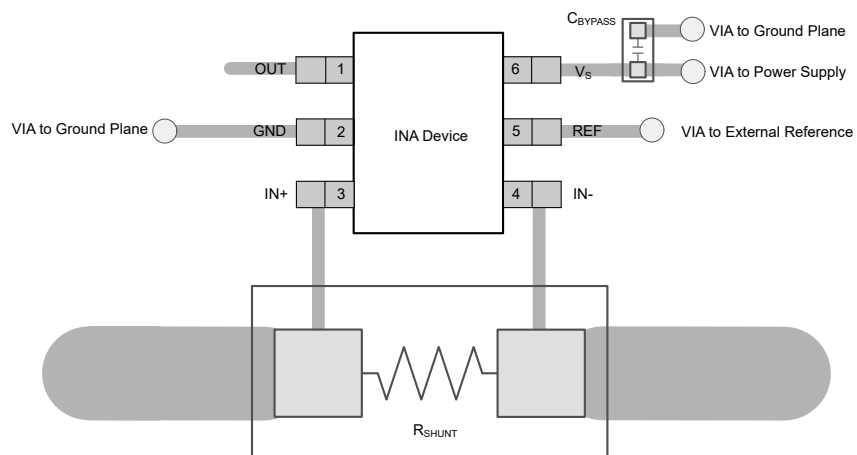


图 7-3. INA299 SOT-23 6 引脚 (DBV) 封装建议布局

8 器件和文档支持

8.1 文档支持

8.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档：德州仪器 (TI)，

- 德州仪器 (TI)，[INA299xEVM](#)，EVM 用户指南

8.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击右上角的 *提醒我* 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

8.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

8.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

8.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

8.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	注释
May 2025	*	初始发行版

10 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

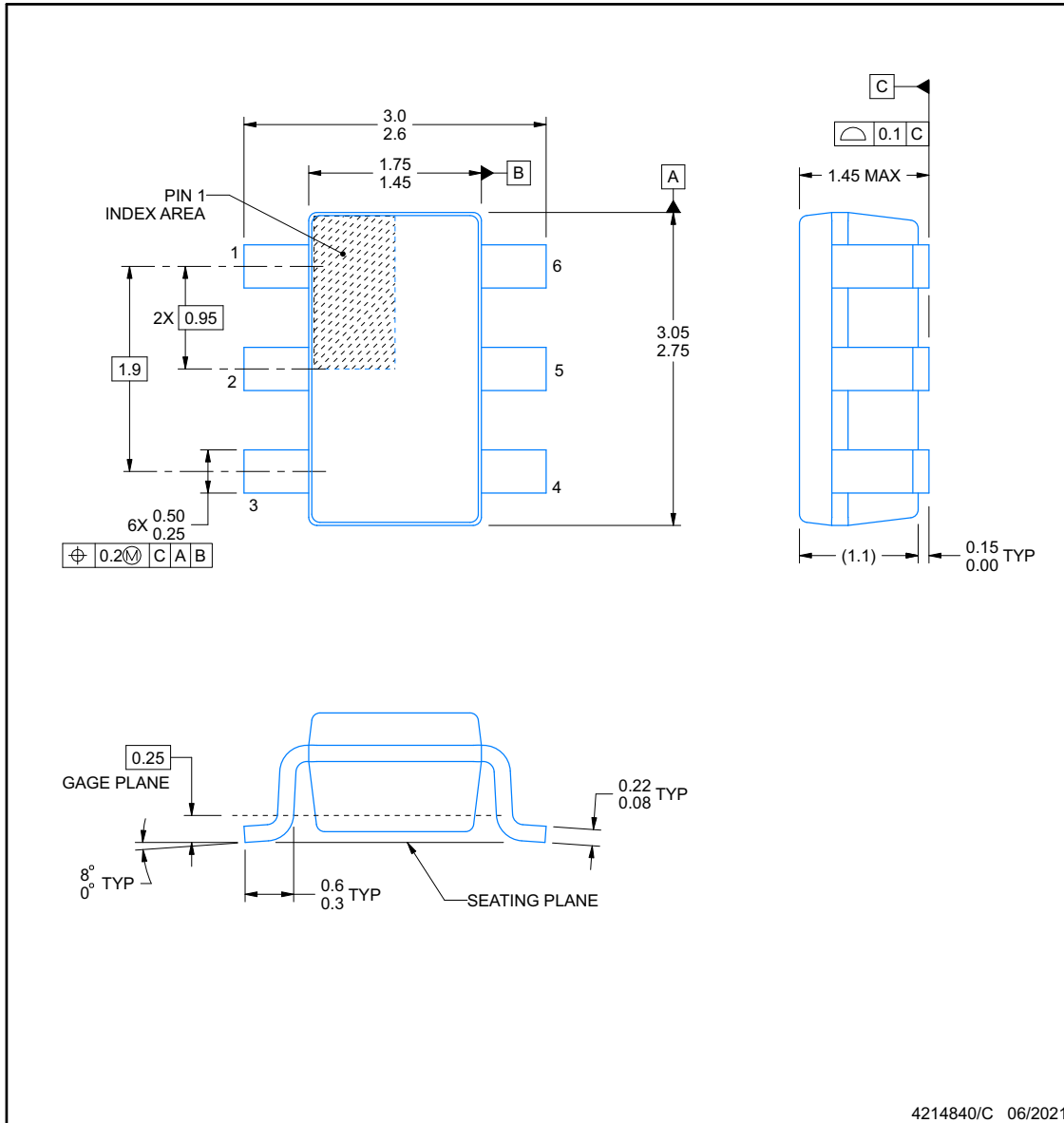
10.1 机械数据



DBV0006A

PACKAGE OUTLINE
SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

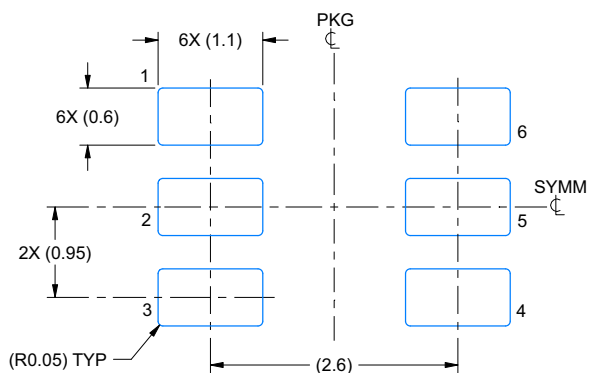


NOTES:

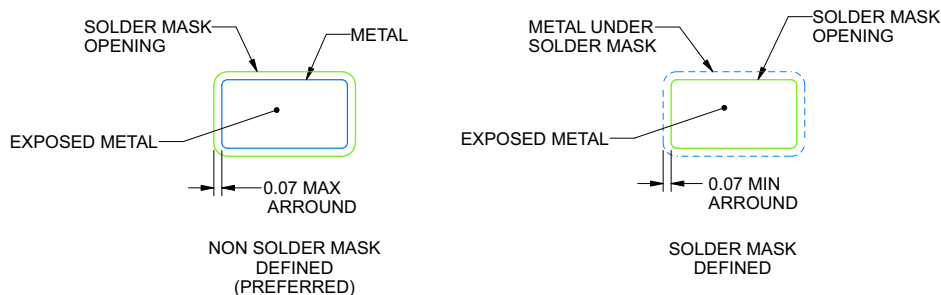
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Body dimensions do not include mold flash or protrusion. Mold flash and protrusion shall not exceed 0.25 per side.
4. Leads 1,2,3 may be wider than leads 4,5,6 for package orientation.
5. Reference JEDEC MO-178.

EXAMPLE BOARD LAYOUT**DBV0006A****SOT-23 - 1.45 mm max height**

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X

**SOLDER MASK DETAILS**

4214840/C 06/2021

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

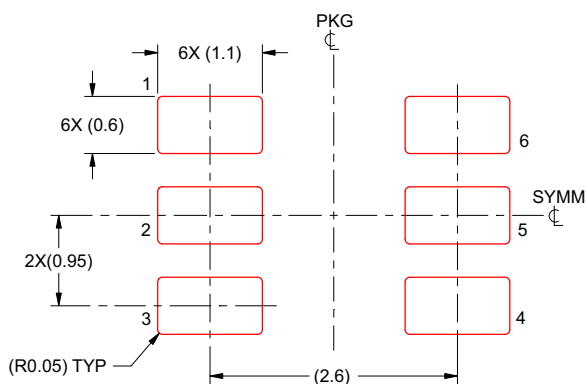
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0006A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214840/C 06/2021

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

封装选项附录

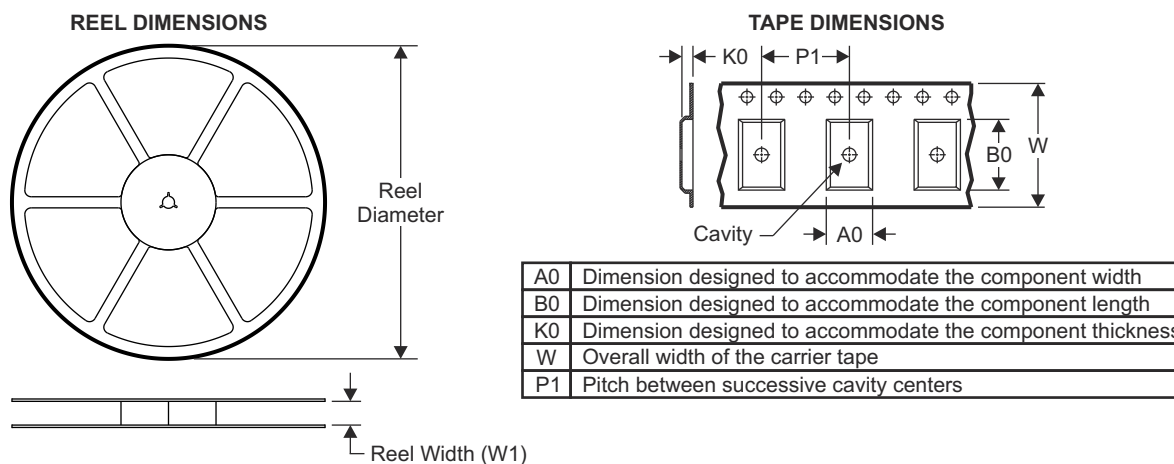
可订购器件	状态 ⁽¹⁾	封装类型	封装图	引脚	包装数量	环保计划 ⁽²⁾	引脚镀层/焊球材料 ⁽⁶⁾	MSL 峰值温度 ⁽³⁾	工作温度 (°C)	器件标识 ^{(4) (5)}
INA299A1IDBVR	运行	SOT-23	DRV	6	3000	RoHS 和绿色环保	雾锡	Level-1-260C-UNLIM	-40 至 125	3OPF
INA299A2IDBVR	运行	SOT-23	DRV	6	3000	RoHS 和绿色环保	雾锡	Level-1-260C-UNLIM	-40 至 125	3OQF
INA299A3IDBVR	运行	SOT-23	DRV	6	3000	RoHS 和绿色环保	雾锡	Level-1-260C-UNLIM	-40 至 125	3ORF

- (1) 销售状态值定义如下：
正在供货：建议用于新设计的产品器件。
限期购买：TI 已宣布器件即将停产，但仍在购买期限内。
NRND：不推荐用于新设计。为支持现有客户，器件仍在生产，但 TI 不建议在新设计中使用此器件。**预发布**：器件已发布，但未量产。可能提供样片，也可能无法提供样片。
已停产：TI 已停止生产该器件。
- (2) **RoHS**：TI 定义的“RoHS”是指半导体产品符合针对所有 10 种 RoHS 物质的现行 EU RoHS 要求，包括要求 RoHS 物质不超过均质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求，因此“RoHS”产品适用于指定的无铅作业。TI 可将这类产品标记为“无铅”。
RoHS 豁免：TI 定义的“RoHS 豁免”是指含铅、但根据特定 EU RoHS 豁免规定符合 EU RoHS 标准的产品。
绿色：TI 定义的“绿色”是指氯 (CL) 和溴 (Br) 阻燃剂的含量符合 JS709B 中 ≤1000ppm 阈值的低卤要求。基于三氧化二锑的阻燃剂也必须符合 ≤1000ppm 的阈值要求。
- (3) MSL，峰值温度- 湿敏等级额定值 (符合 JEDEC 工业标准分级) 和峰值焊接温度。
- (4) 器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标志。
- (5) 如有多个器件标识，将用括号括起来。不过，器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进，说明该行续接上一行，这两行合在一起表示该器件的完整器件标识。
- (6) 引脚镀层/焊球材料 - 可订购器件可能有多种镀层材料选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅镀层/焊球值超出最大列宽，则会折为两行。

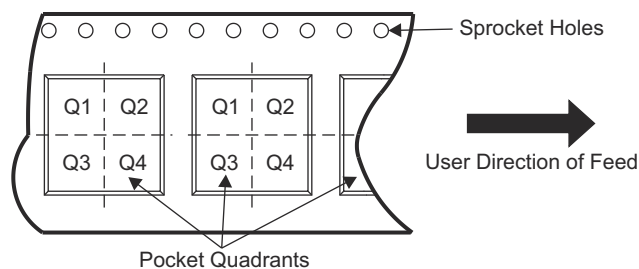
重要信息和免责声明：本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息，TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息，但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息，因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。

在任何情况下，TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。

10.2 卷带包装信息

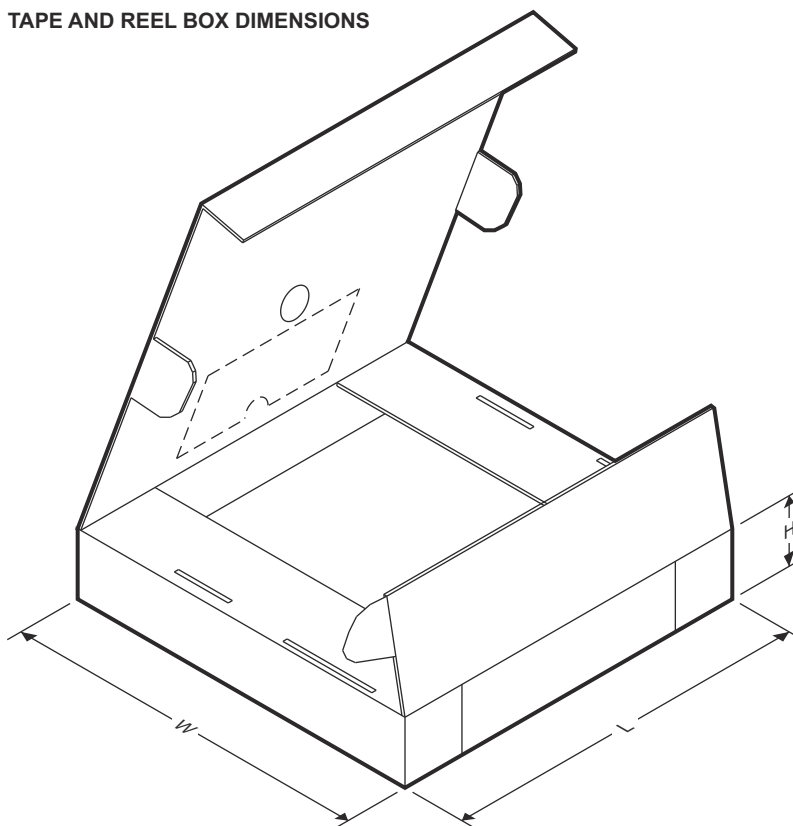


QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	卷带直径 (mm)	卷带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
INA299A1IDBVR	SOT-23	DRV	6	3000	180	8.4	3.2	3.2	1.4	4	8	3
INA299A2IDBVR	SOT-23	DRV	6	3000	180	8.4	3.2	3.2	1.4	4	8	3
INA299A3IDBVR	SOT-23	DRV	6	3000	180	8.4	3.2	3.2	1.4	4	8	3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
INA299A1IDBVR	SOT-23	DRV	6	3000	210	185	35
INA299A2IDBVR	SOT-23	DRV	6	3000	210	185	35
INA299A3IDBVR	SOT-23	DRV	6	3000	210	185	35

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司